

新しいIDCH技術により

最大4GHzまでRFパワー性能を 大幅に向上する28V / 32V LDMOS



最大4GHzの周波数で優れた性能を提供する新しいIDCHパワーRF LDMOS技術

より短い伝導チャンネル長と高いブレイクダウン電圧を兼ね備えた新しいLDMOSファミリは、RFパワー・アンプや、2.45GHzの産業 / 科学 / 医療 (ISM) または通信およびSバンド・レーダー・システムに最適です。

STの革新的なIDCH技術により、対応可能なアプリケーション範囲を拡大し、優れた性能およびコスト効率の良いパワーRFソリューションを提供します。

特徴

- 高い効率
- 低い熱抵抗
- 最適化されたパワーRFパッケージ
- 動作周波数 : 最大4GHz

利点

- 消費電力の節減
- クラス最高レベルの信頼性
- コスト効率に優れたソリューション

アプリケーション

- 2.45GHz ISM
- セルラー・インフラストラクチャ
- IMT用1.4/1.5GHz帯
- 衛星通信
- Sバンド・レーダー
- ワイドバンド・ラジオ

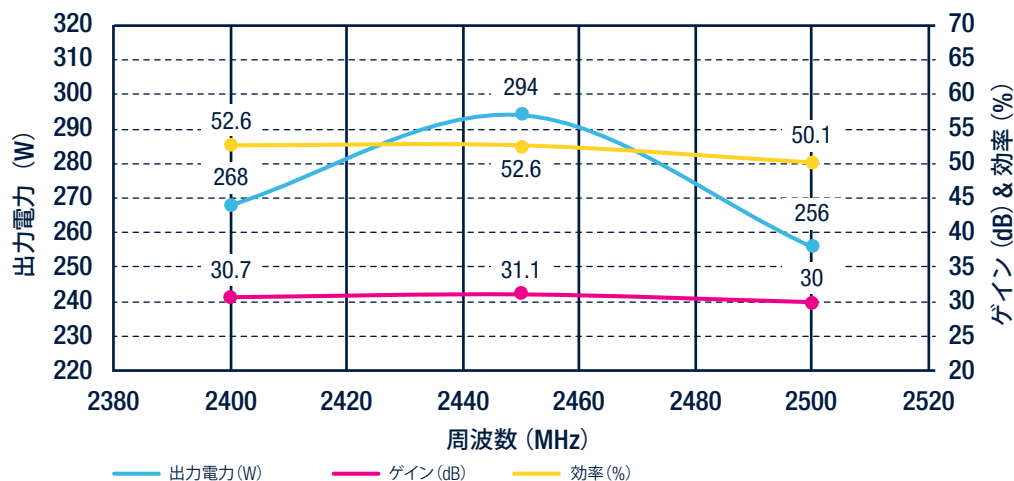
IDCH技術

28V/32Vの動作電圧で最大4GHz

IDCHは、28V/32Vコモン・ソースNチャネル・エンハンスメント・モード・ラテラル電界効果RFパワー・トランジスタ技術です。STのIDCHポートフォリオは出力パワーが8W~300Wで、2.45GHz ISM、ワイヤレス・インフラストラクチャ、衛星通信、およびSバンド・レーダー機器専用に設計され、最大4GHzの動作周波数でさまざまな種類の変調形式に対応します。

電力ゲインと効率と出力電力 ($V_{DD} = 30V$)

(RF2L27015CG2 + RF2L24280CB4 + サーキュレータ構成の評価ボード)



品名	パッケージ	周波数 (MHz)	出力電力 (W)	電力ゲイン (dB)	電源電圧 (V)	効率 (%)
RF2L42008CG2*	E2	4200	8	14	28	40
RF2L27015CG2*	E2	2700	15	18	28	60
ST36015	E2	3450	15	15	28	45
RF2L27025CG2*	E2	2700	35	18	28	55
RF2L36040CF2*	A2	3500	40	13	28	45
ST16045	A2	1615	45	19	28	65
RF2L36075CF2*	B2	3500	75	12.7	28	45
RF2L16080CF2*	A2	1615	80	19	28	58
RF2L16180CF2*	B2	1470	180	19	28	59
RF2L16180CB4*	B4E	1457	180	16	28	58
RF2L15200CB4*	LBB	1300	200	18	28	65
ST24180	B2	2350	180	14	32	55
RF2L24280CB4*	D4/D4E	2450	300	15	32	57

* 開発中



© STMicroelectronics - September 2020 - Printed in Japan - All rights reserved
 STMicroelectronicsのロゴマークは、STMicroelectronics Groupの登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者に帰属します。
 STマイクロエレクトロニクス株式会社 ■東京 TEL 03-5783-8200 ■大阪 TEL 06-6397-4130 ■名古屋 TEL 052-259-2725



life.augmented